

深圳市恒某公司诉国家知识产权局、陈某建实用新型专利权无效行政纠纷案

——实用新型专利创造性判断中对相近、相关技术领域的确定

关键词 行政 实用新型专利权无效 创造性 相同技术领域 相近技术领域

基本案情

陈某建系专利号为201620169331.2、名称为“铝栅CMOS双层金属布线的版图结构”的实用新型专利的专利权人。2020年7月15日，深圳市恒某公司针对该专利权提出无效宣告请求，对此国家知识产权局于2021年1月4日作出第47707号无效宣告请求审查决定，宣告该专利权有效。深圳市恒某公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2021年9月22日作出（2021）京73行初7955号行政判决：驳回深圳市恒某公司的诉讼请求。深圳市恒某公司提出上诉，最高人民法院于2022年12月29日作出（2022）最高法知行终41号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2021）京73行初7955号行政判决；二、撤销国家知识产权局第47707号无效宣告请求审查决定；三、国家知识产权局就深圳市恒某公司针对专利号为201620169331.2、名称为“铝栅CMOS双层金属布线的版图结构”的实用新型专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

裁判理由

法院生效裁判认为，技术领域的确定，应当以权利要求所限定的内容为准，一般根据专利的主题名称，结合技术方案所实现的技术功能、

用途加以确定。相近的技术领域一般指与实用新型专利产品功能以及具体用途相近的领域，相关的技术领域一般指实用新型专利与最接近的现有技术的区别技术特征所应用的功能领域。

该专利权利要求1要求保护的是一种铝栅CMOS双层金属布线的版图结构，旨在解决现有技术中单层金属的铝栅CMOS工艺设计的产品集成度低的问题。为了解决上述问题，该专利权利要求1采取的技术手段主要是：将现有的单层铝栅CMOS金属布线结构的压焊点（输入和输出PAD、电源和地端PAD）作为第二层金属结构设置于第一金属层金属结构上，也就是设置到铝栅CMOS结构之上，提高铝栅CMOS集成度。为了评价该专利权利要求1版图结构的创造性，一审判决及被诉决定基于硅栅和铝栅的栅极材料不同，均认为硅栅CMOS集成电路和铝栅CMOS集成电路属于不同的技术领域，进而认定二者的技术方案实质上并不相同，该专利权利要求1具备创造性。该专利权利要求1与证据1、2、3、5、6、7的区别技术特征在于，证据1、2、3、5、6、7公开的均是硅栅CMOS金属布线结构，并没有公开任何涉及“铝栅”的内容。在半导体工业的早期，金属铝一般被用作CMOS的栅极材料，此后硅被广泛运用于栅极材料。尽管栅极材料从铝到硅的发展确实是半导体器件的改进，但铝栅与硅栅的区别对于该专利所采取的双层金属布线版图结构的技术方案没有实质性影响，栅极材料的选择不应作为该专利的技术贡献。因此，该专利与硅栅CMOS双层金属布线结构功能相同、用途相近，提高CMOS集成度的原理基本相同，可以将硅栅CMOS双层金属布线结构视为该专利的相同或相近技术领域。被诉决定和一审判决在评价该专利的创造性时，未考虑硅栅CMOS双层金属布线结构，属于适用法律错误。

裁判要旨

确定实用新型专利的技术领域时，应当以权利要求所限定的技术方

案为对象，以主题名称为起点，综合考虑专利技术方案的功能、用途。与专利技术方案的功能、用途相近的技术领域，构成专利技术领域的相近技术领域；专利技术方案与最接近现有技术的区别技术特征所应用的技术领域，构成专利技术领域的相关技术领域。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第3款）

一审：北京知识产权法院（2021）京73行初7955号行政判决
（2021年9月22日）

二审：最高人民法院（2022）最高法知行终41号行政判决（2022年12月29日）